

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載
 【部門区分】第7部門第2区分
 【発行日】平成19年2月8日(2007.2.8)

【公開番号】特開2004-207731(P2004-207731A)

【公開日】平成16年7月22日(2004.7.22)

【年通号数】公開・登録公報2004-028

【出願番号】特願2003-423432(P2003-423432)

【国際特許分類】

H 01 L 21/306 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/306 N

【手続補正書】

【提出日】平成18年12月18日(2006.12.18)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

集積回路デバイスの製造方法であって、a) 1つ以上のリフトオフ層を基体上に配置するステップと、b) 架橋コーティングの1つ以上の層を前記リフトオフ層上に配置するステップと、c) 前記基体にパターン形成するステップと、d) 前記コーティングおよびリフトオフ層を除去するステップとを含み、前記基体は、強誘電性ポリマー、誘電材料、またはその両方の1つ以上の層を含み、前記誘電材料は誘電率3を有し、前記リフトオフ層は有機ポリマー材料である製造方法。

【請求項2】

前記リフトオフ層がポリグルタルイミドを含む請求項1記載の方法。

【請求項3】

前記ポリグルタルイミドが50,000の分子量を有する請求項2記載の方法。

【請求項4】

前記リフトオフ層が光吸収性材料をさらに含む請求項1から3のいずれか1項記載の方法。

【請求項5】

前記リフトオフ層が架橋ポリマー粒子を含む請求項1から4のいずれか1項記載の方法。

。

【請求項6】

前記誘電材料が2.8の誘電率を有する請求項1から5のいずれか1項記載の方法。

【請求項7】

前記リフトオフ層が、溶剤との接触によって除去される請求項1から6のいずれか1項記載の方法。

【請求項8】

前記リフトオフ層が2500の厚さを有する請求項1から7のいずれか1項記載の方法。

【請求項9】

強誘電性ポリマー、誘電率3を有する誘電材料、またはその両方の1つ以上の層と、1つ以上のリフトオフ層と、前記リフトオフ層上の架橋コーティングの1つ以上の層とを含む集積回路デバイスであって、前記リフトオフ層が有機ポリマー材料である集積回路デ

バイス。

【請求項 10】

誘電材料が、誘電率 3 を有する請求項 13 記載の集積回路デバイス。